



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



## Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China



**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

**IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter**

**Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{C\ nom}$ $I_C$	100 140	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_P = 1\ \text{ms}, T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{CRM}$	200	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$P_{tot}$	480	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/-20	V

**Charakteristische Werte / characteristic values**

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 100\ \text{A}, V_{GE} = 15\ \text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_C = 100\ \text{A}, V_{GE} = 15\ \text{V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\ sat}$		1,70 2,00	2,15	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 4,00\ \text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{GEth}$	5,0	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\ \text{V} \dots +15\ \text{V}$	$Q_G$		0,90		$\mu\text{C}$
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$R_{Gint}$		7,5		$\Omega$
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\ \text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}$	$C_{ies}$		7,10		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\ \text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}$	$C_{res}$		0,30		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{CES}$			5,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\ \text{V}, V_{GE} = 20\ \text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{GES}$			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	$I_C = 100\ \text{A}, V_{CE} = 600\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Gon} = 3,9\ \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Gon} = 3,9\ \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d\ on}$		0,26 0,29		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 100\ \text{A}, V_{CE} = 600\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Gon} = 3,9\ \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Gon} = 3,9\ \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_r$		0,03 0,05		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	$I_C = 100\ \text{A}, V_{CE} = 600\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Goff} = 3,9\ \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Goff} = 3,9\ \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d\ off}$		0,42 0,52		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 100\ \text{A}, V_{CE} = 600\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Goff} = 3,9\ \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Goff} = 3,9\ \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_f$		0,07 0,09		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 100\ \text{A}, V_{CE} = 600\ \text{V}, L_S = 50\ \text{nH}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Gon} = 3,9\ \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Gon} = 3,9\ \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{on}$		6,30 9,00		mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 100\ \text{A}, V_{CE} = 600\ \text{V}, L_S = 50\ \text{nH}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Goff} = 3,9\ \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Goff} = 3,9\ \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{off}$		8,30 13,5		mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$t_P \leq 10\ \mu\text{s}, V_{GE} \leq 15\ \text{V}$ $T_{vj} \leq 125^{\circ}\text{C}, V_{CC} = 900\ \text{V}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$I_{SC}$		400		A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT per IGBT	$R_{thJC}$			0,26	K/W

prepared by: Christian Wolf	date of publication: 2003-7-31
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

**Diode-Wechselrichter / diode-inverter**

**Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	1200	V
Dauergleichstrom DC forward current		$I_F$	100	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_p = 1\text{ ms}$	$I_{FRM}$	200	A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$V_R = 0\text{ V}, t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	1950	$\text{A}^2\text{s}$

**Charakteristische Werte / characteristic values**

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 100\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_F = 100\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_F$		1,65 1,65	2,15	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 100\text{ A}, -di_F/dt = 2600\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600\text{ V}, V_{GE} = -15\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600\text{ V}, V_{GE} = -15\text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I_{RM}$		120 140		A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 100\text{ A}, -di_F/dt = 2600\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600\text{ V}, V_{GE} = -15\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600\text{ V}, V_{GE} = -15\text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$Q_r$		10,0 20,0		$\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 100\text{ A}, -di_F/dt = 2600\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600\text{ V}, V_{GE} = -15\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600\text{ V}, V_{GE} = -15\text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{rec}$		4,20 8,00		mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	$R_{thJC}$			0,48	K/W

**Strommesswiderstand / shunt**

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	$T_c = 20^{\circ}\text{C}$	$R_{20}$		1,50		m $\Omega$
Temperaturkoeffizient temperature coefficient (tcr)	$20^{\circ}\text{C}-60^{\circ}\text{C}$			<30		ppm/K
Belastbarkeit pro Shunt-Widerstand load capacity per shunt-resistor	$T_c = 80^{\circ}\text{C}$	P			20	W
Betriebstemperatur Shunt-Widerstand operation temperatur shunt-resistor		$T_{tvjop}$			140	$^{\circ}\text{C}$
Innerer Wärmewiderstand; DC thermal resistance; junction to case		$R_{thJC}$			2,9	K/W

prepared by: Christian Wolf	date of publication: 2003-7-31
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

# Technische Information / technical information

IGBT-Module  
IGBT-modules

## FS100R12KE3\_B3



### Vorläufige Daten preliminary data

#### Modul / module

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	V <sub>ISO</sub>	2,5			kV
Material für innere Isolation material for internal insulation			Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			
Kriechstrecke creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		10,0			mm
Luftstrecke clearance distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		7,50			mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index		CTI	> 225			
			min.	typ.	max.	
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	R <sub>thCH</sub>		0,009		K/W
Modulinduktivität stray inductance module		L <sub>sCE</sub>		21		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	T <sub>C</sub> = 25°C, pro Schalter / per switch	R <sub>CC'-EE'</sub>		1,80		mΩ
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T <sub>vj max</sub>			150	°C
Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions		T <sub>vj op</sub>	-40		125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T <sub>stg</sub>	-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	Schraube / screw M5	M	3,00	-	6,00	Nm
Gewicht weight		G		300		g

**Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.**

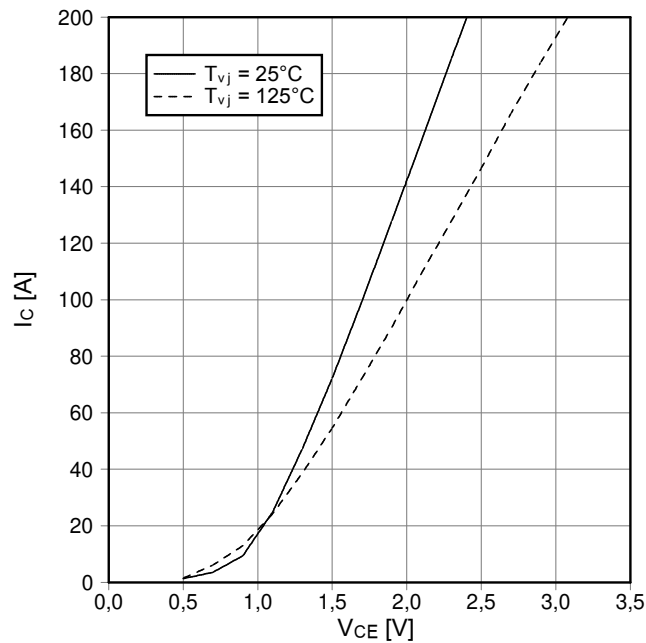
**This technical information specifies semiconductor devices but guarantees no characteristics. It is valid with the appropriate technical explanations.**

prepared by: Christian Wolf	date of publication: 2003-7-31
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

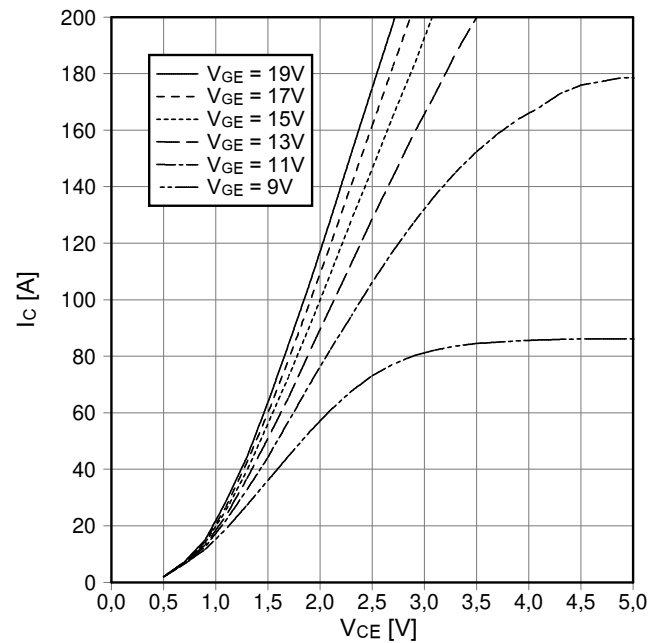
**Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**output characteristic IGBT-inverter (typical)**

$I_c = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



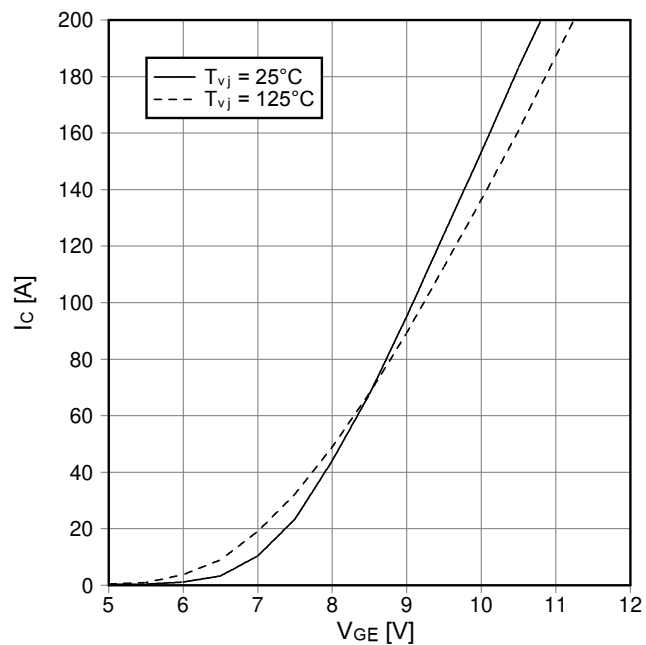
**Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**output characteristic IGBT-inverter (typical)**

$I_c = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



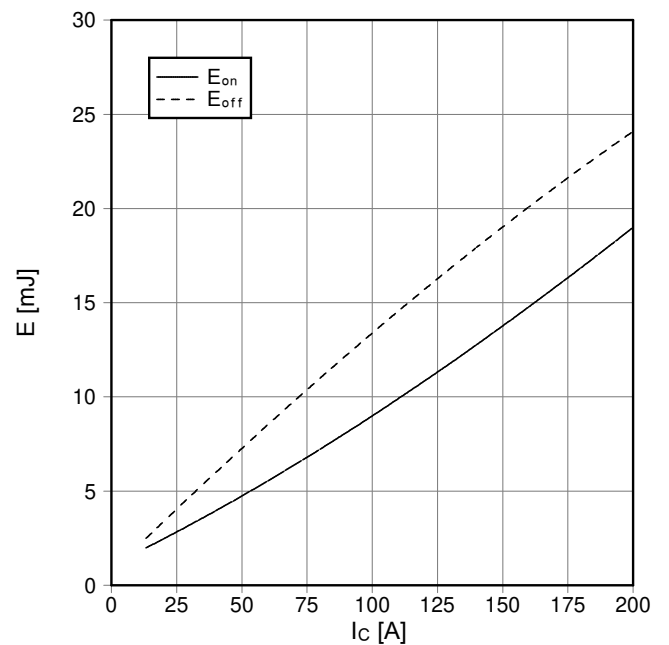
**Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**transfer characteristic IGBT-inverter (typical)**

$I_c = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



**Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**switching losses IGBT-inverter (typical)**

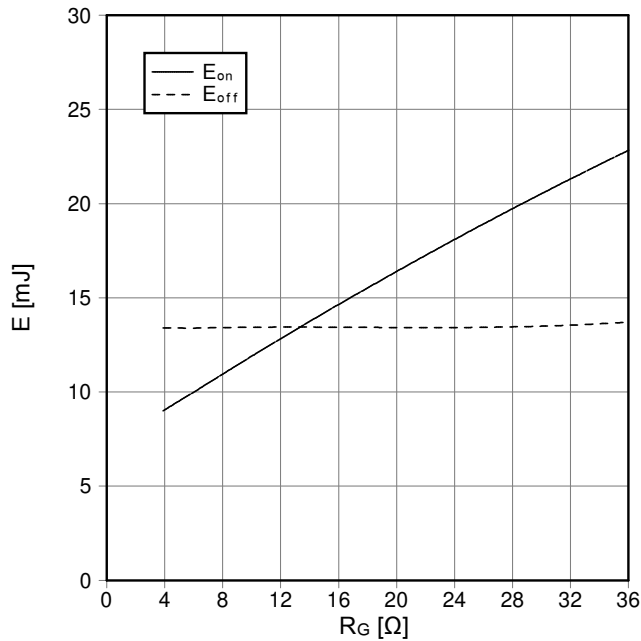
$E_{on} = f(I_c)$ ,  $E_{off} = f(I_c)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 3,9\ \Omega$ ,  $R_{Goff} = 3,9\ \Omega$ ,  $V_{CE} = 600\text{ V}$ ,  
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



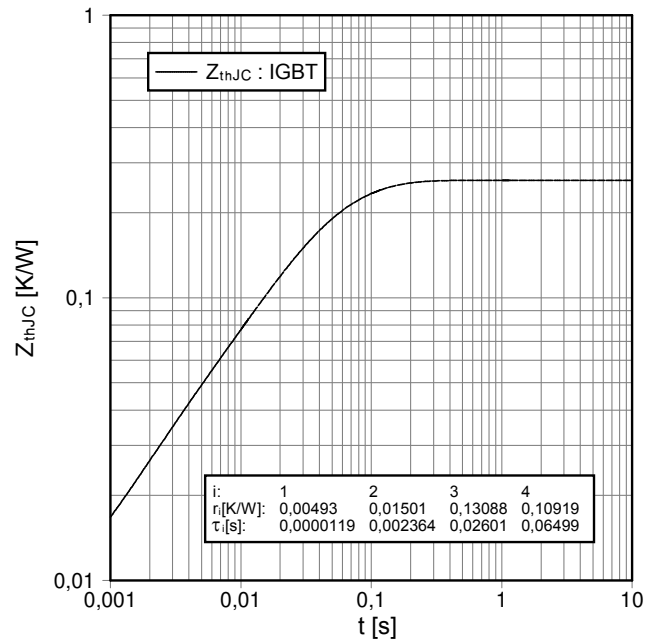
prepared by: Christian Wolf	date of publication: 2003-7-31
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

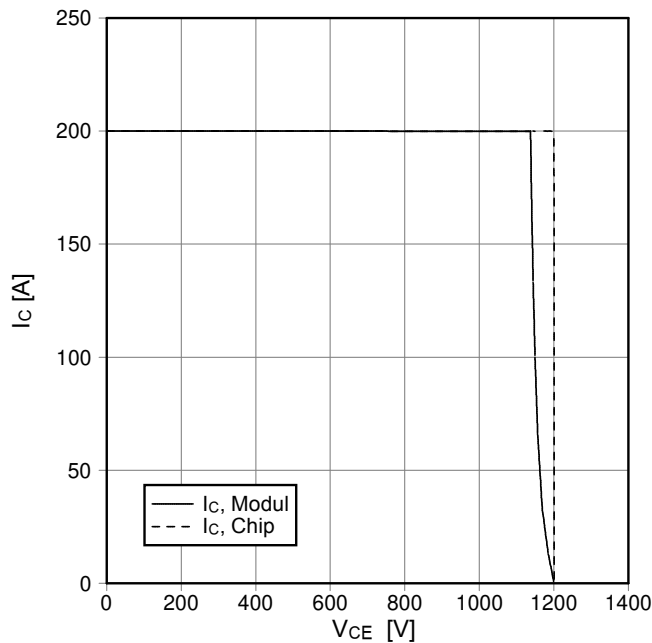
**Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**switching losses IGBT-Inverter (typical)**  
 $E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $I_C = 100\text{ A}$ ,  $V_{CE} = 600\text{ V}$ ,  $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



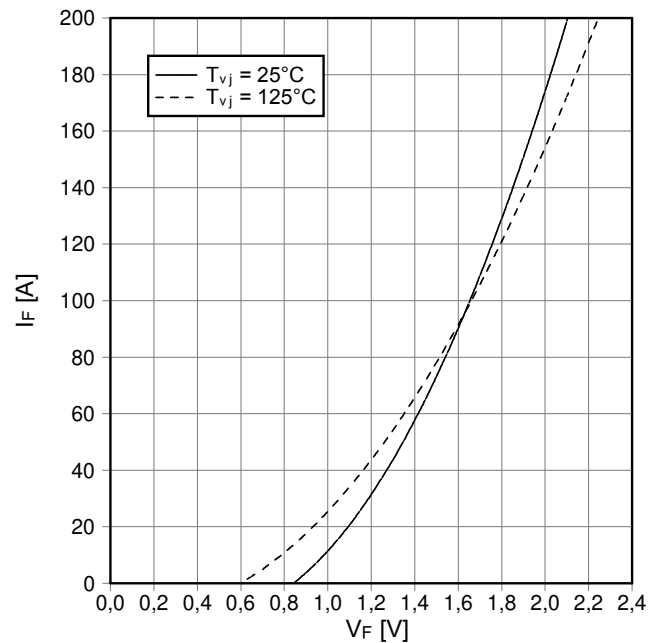
**Transienter Wärmewiderstand IGBT-Wechselr.**  
**transient thermal impedance IGBT-inverter**  
 $Z_{thJC} = f(t)$



**Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT-Wr. (RBSOA)**  
**reverse bias safe operating area IGBT-inv. (RBSOA)**  
 $I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Goff} = 3,9\ \Omega$ ,  $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



**Durchlaßkennlinie der Diode-Wechselr. (typisch)**  
**forward characteristic of diode-inverter (typical)**  
 $I_F = f(V_F)$

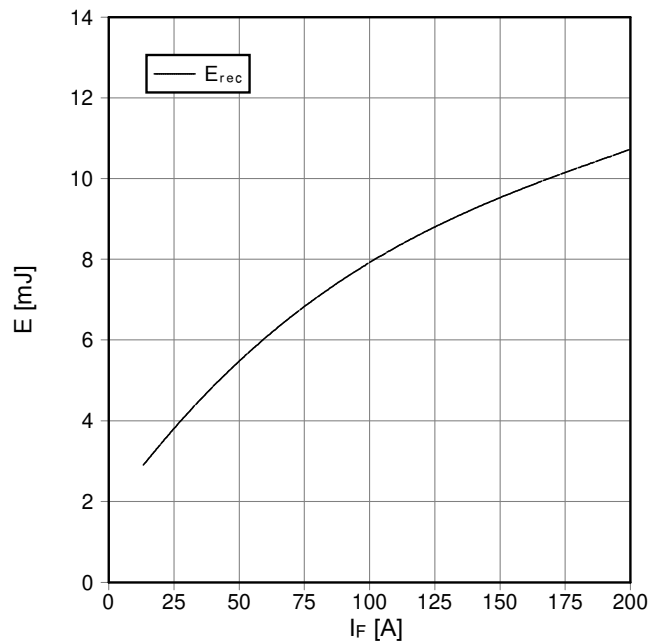


prepared by: Christian Wolf	date of publication: 2003-7-31
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

**Vorläufige Daten  
preliminary data**

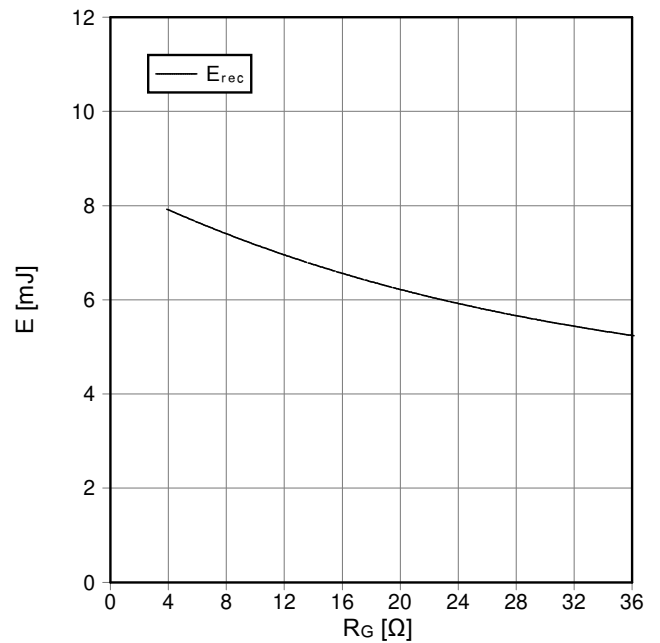
Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)  
switching losses diode-inverter (typical)

$E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 3,9 \Omega$ ,  $V_{CE} = 600 V$ ,  $T_{vj} = 125^\circ C$



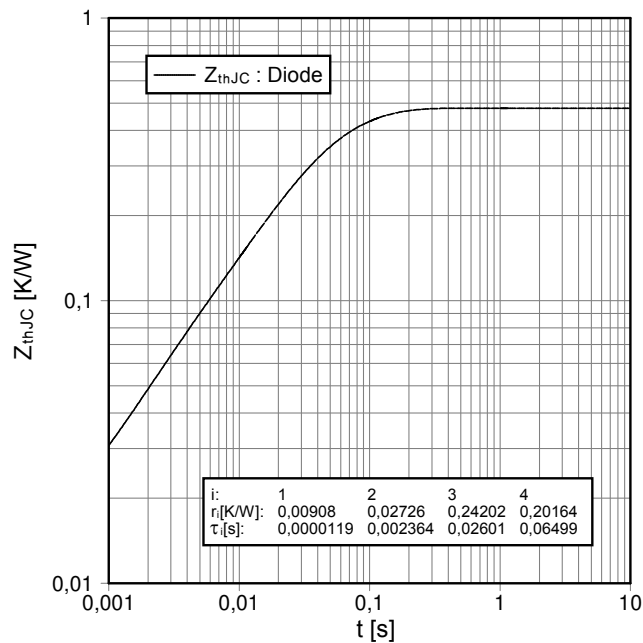
Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)  
switching losses diode-inverter (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 100 A$ ,  $V_{CE} = 600 V$ ,  $T_{vj} = 125^\circ C$



Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselr.  
transient thermal impedance diode-inverter

$Z_{thJC} = f(t)$

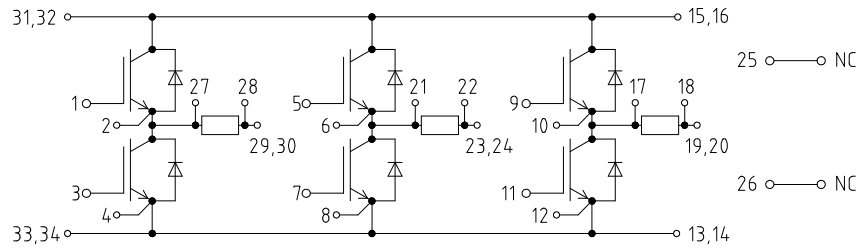


i:	1	2	3	4
$r_i$ [K/W]:	0,00908	0,02726	0,24202	0,20164
$\tau_i$ [s]:	0,0000119	0,002364	0,02601	0,06499

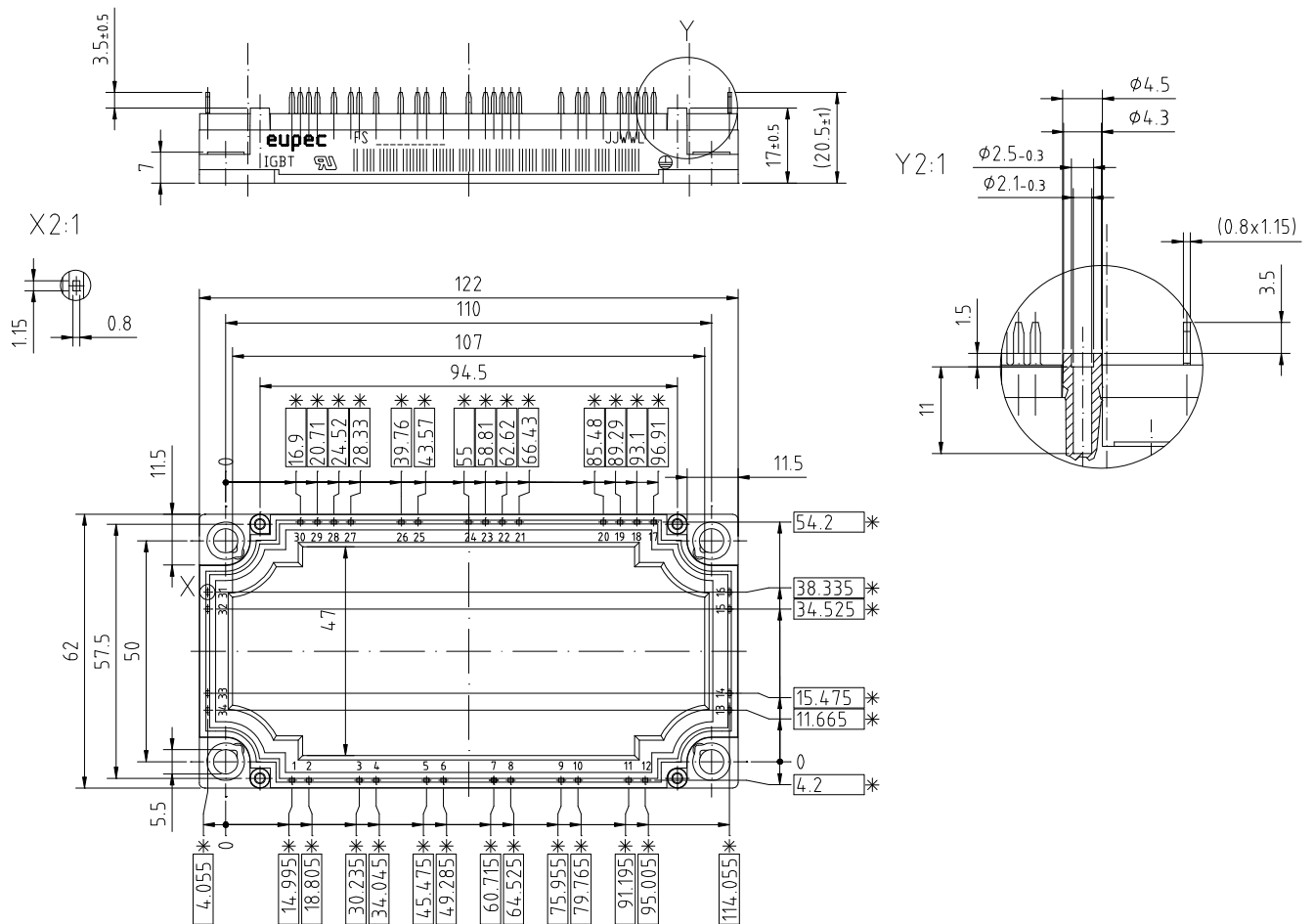
prepared by: Christian Wolf	date of publication: 2003-7-31
approved by: Robert Severin	revision: 2.0

Vorläufige Daten  
preliminary data

Schaltplan / circuit diagram



Gehäuseabmessungen / package outlines



\* = alle Maße mit einer Toleranz von



prepared by: Christian Wolf	date of publication: 2003-7-31
approved by: Robert Severin	revision: 2.0



## **Nutzungsbedingungen**

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.eupec.com](http://www.eupec.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

## **Terms & Conditions of usage**

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see [www.eupec.com](http://www.eupec.com), sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify.

Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.